

# □ 2T3129A9, 2T3129B9, 2T3129B9, 2T3129Г9, 2T3129Д9

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р универсальные. Предназначены для применения в усилителях, генераторах, стабилизаторах напряжения и в импульсных устройствах. Выпускаются в миниатюрном пластмассовом корпусе, тип корпуса КТ-46. Масса транзистора не более 0,01 г.



## Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при

$U_{ce} = 5$ В, $I_e = 2$ мА:	
$T = +25^\circ\text{C}$ 2T3129A9	30...120
2T3129B9, 2T3129B9	80...250
2T3129Г9, 2T3129Д9	200...500
$T = +85^\circ\text{C}$ 2T3129A9	30...300
2T3129B9, 2T3129B9	80...600
2T3129Г9, 2T3129Д9	200...1000
$T = -60^\circ\text{C}$ 2T3129A9	15...120
2T3129B9, 2T3129B9	30...250
2T3129Г9, 2T3129Д9	80...500

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при

$U_{ce} = 5$ В, $I_e = 10$ мА, $f = 100$ МГц, не менее	2
--------------------------------------------------------	---

Границочное напряжение при  $I_e = 10$  мА, не менее:

2T3129A9, 2T3129B9	40 В
2T3129B9, 2T3129Г9	20 В
2T3129Д9	15 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при

$I_e = 10$ мА, $I_c = 1$ мА, не более	0,2 В
---------------------------------------	-------

Напряжение насыщения база-эмиттер при  $I_e = 10$  мА,

$I_b = 1$ мА, не более	1 В
------------------------	-----

Обратный ток коллектора, не более:

$T = +25^\circ\text{C}$ 2T3129A9, 2T3129B9 при $U_{ce} = 50$ В	0,5 мкА
2T3129B9, 2T3129Г9 при $U_{ce} = 30$ В	0,5 мкА
2T3129Д9 при $U_{ce} = 20$ В	0,5 мкА

$T = +85^\circ\text{C}$ 2T3129A9, 2T3129B9 при $U_{ce} = 50$ В	5 мкА
2T3129B9, 2T3129Г9 при $U_{ce} = 30$ В	5 мкА
2T3129Д9 при $U_{ce} = 20$ В	5 мкА

$T = -60^\circ\text{C}$ 2T3129A9, 2T3129B9 при $U_{ce} = 50$ В	0,5 мкА
2T3129B9, 2T3129Г9 при $U_{ce} = 30$ В	0,5 мкА
2T3129Д9 при $U_{ce} = 20$ В	0,5 мкА

Обратный ток эмиттера при $U_{ce} = 5$ В, не более	5 мкА
----------------------------------------------------	-------

## Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:

2T3129A9, 2T3129B9	50 В
2T3129B9, 2T3129Г9	30 В
2T3129Д9	20 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при  $R_{ce} = 1$  кОм:

2T3129A9, 2T3129B9	40 В
2T3129B9, 2T3129Г9, 2T3129Д9	20 В

Постоянное напряжение эмиттер-база

Постоянный ток коллектора	100 мА
---------------------------	--------

Импульсный ток коллектора при  $t_{tr} < 1$  мкс,  $Q > 10$

$T = -60...+25^\circ\text{C}$	200 мА
-------------------------------	--------

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при

$t_{tr} < 1$ мкс, $Q > 10$ , $T = -60...+25^\circ\text{C}$	0,3 Вт
------------------------------------------------------------	--------

Температура р-п перехода

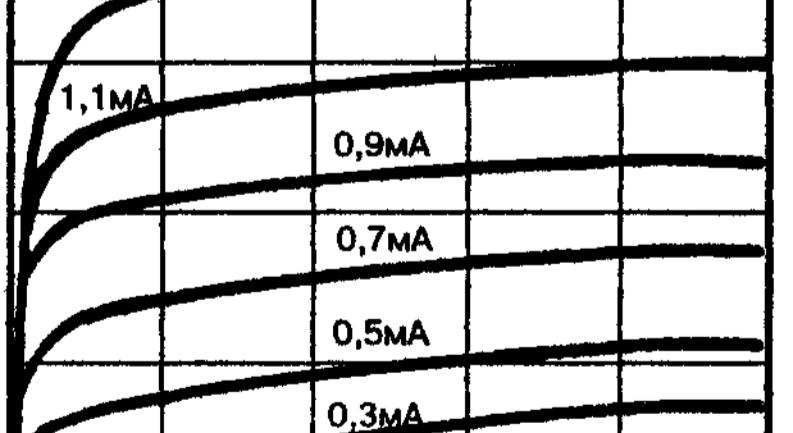
Температура окружающей среды	+125°C
------------------------------	--------

\* При  $T = +25...+85^\circ\text{C}$  постоянная рассеиваемая мощность коллектора определяется

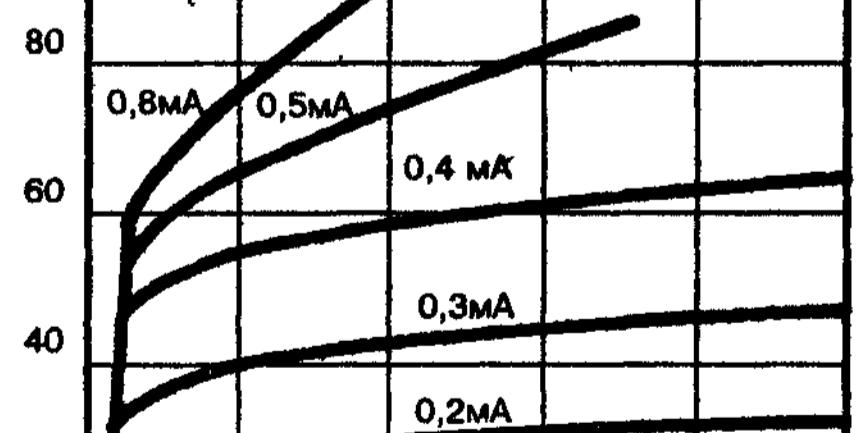
из выражения

$$P_{ce\max} = (125 - T) / 500, \text{ Вт}$$

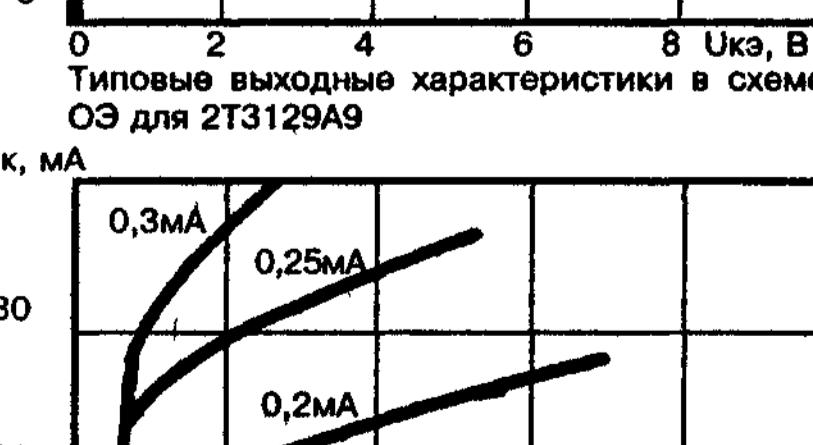
Допустимое значение статического потенциала 2000 В.



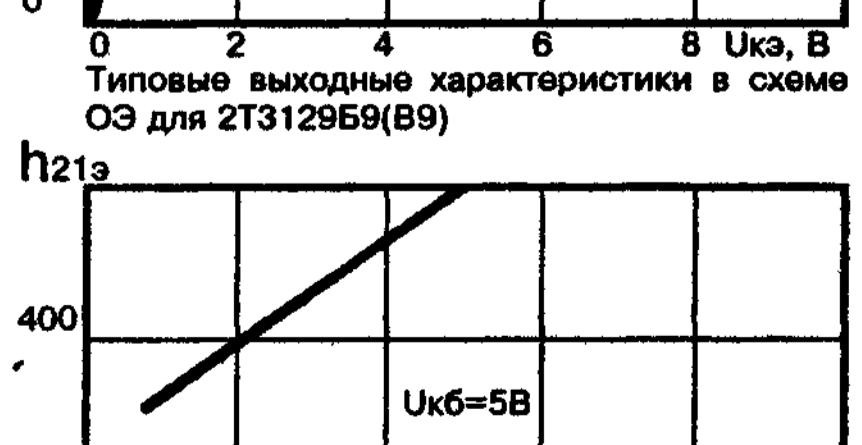
Зависимость модуля коэффициента передачи тока на высокой частоте от тока эмиттера  
а)—2T3129A9, б)—2T3129(B9,B9), в)—2T3129(G9,D9)  $U_{ce}=5$  В



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора  
 $I_c/I_b=10$



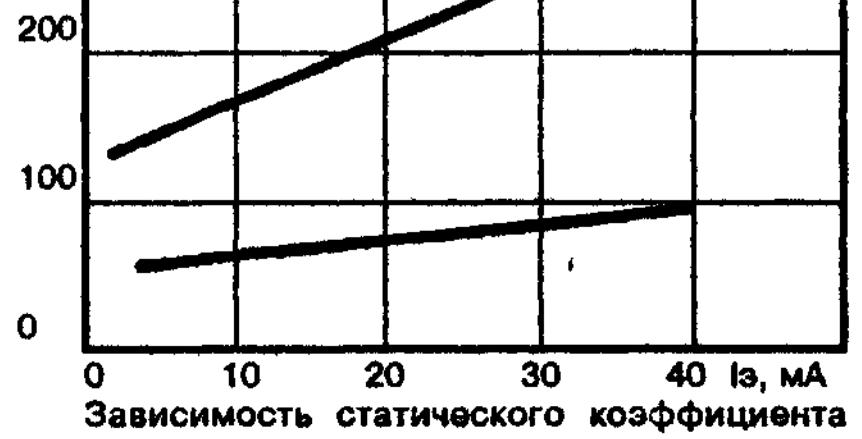
Типовые выходные характеристики в схеме ОЭ для 2T3129A9



Типовые выходные характеристики в схеме ОЭ для 2T3129B9(B9)



Типовые выходные характеристики в схеме ОЭ для 2T3129Г9(D9)



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера  
 $U_{ce}=5$  В